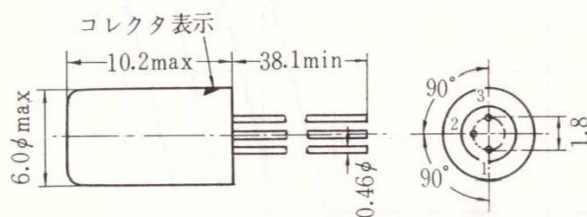


2SC984

シリコン NPN
エピタキシャルプレーナ形
Hi Fi 出力増幅用

SILICON NPN EPITAXIAL PLANAR
Hi Fi POWER OUTPUT



(JEDEC TO-1)

1. エミッタ: Emitter
2. ベース: Base
3. コレクタ: Collector

www.datasheetcatalog.com

■ 最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	50	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	50	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	4	V
コレクタ電流	I_C	500	mA
許容コレクタ損失	P_C	350	mW
接合部温度	T_j	175	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-65~+175	$^\circ\text{C}$

■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

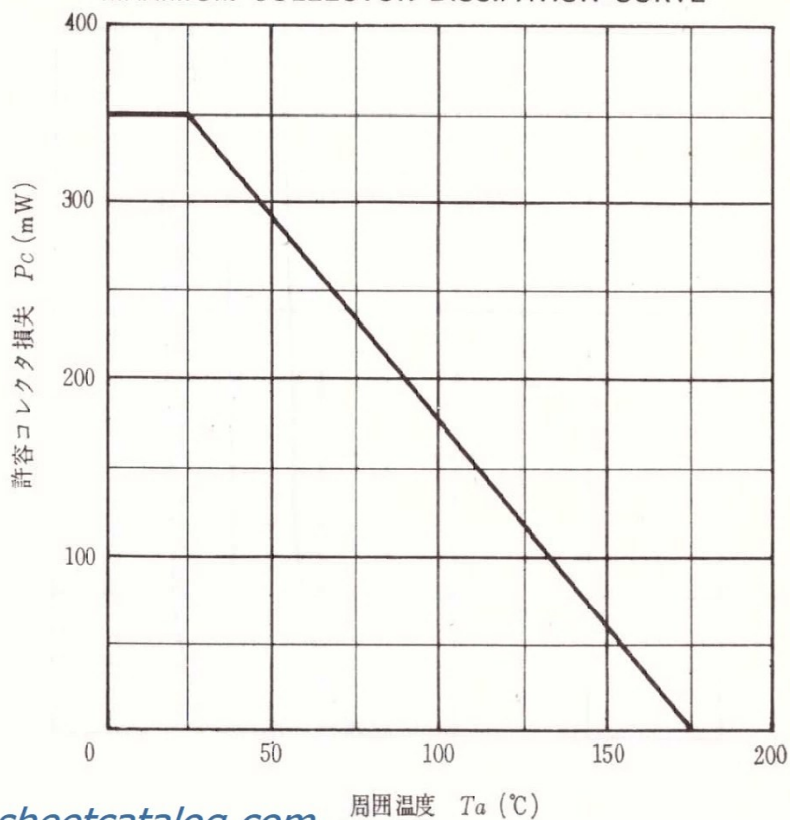
コレクタ・エミッタ破壊電圧		min.	typ.	max.	
$V_{(BR)CEO}$ ($I_C=1\text{mA}$, $R_{BE}=\infty$)	50	—	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧					
$V_{(BR)EBO}$ ($I_E=10\mu\text{A}$, $I_C=0$)	4	—	—	—	V
コレクタ遮断電流					
I_{CBO} ($V_{CB}=20\text{V}$, $I_E=0$)	—	—	—	0.5	μA
直流電流増幅率					
h_{FE}^* ($V_{CE}=3\text{V}$, $I_C=10\text{mA}$)	40	80	320		
直流電流増幅率					
h_{FE} ($V_{CE}=3\text{V}$, $I_C=100\text{mA}$)	40	80	320		
コレクタ・エミッタ飽和電圧					
$V_{CE(sat)}$ ($I_C=150\text{mA}$, $I_B=15\text{mA}$)	—	0.4	1.0	—	V
ベース・エミッタ電圧					
V_{BE} ($V_{CE}=3\text{V}$, $I_C=10\text{mA}$)	—	0.6	—	—	V
利得帯域幅積					
f_T ($V_{CE}=3\text{V}$, $I_C=10\text{mA}$)	—	100	—	—	MHz

* 2SC984 は h_{FE} の値により下記のように4区分し、現品にそれぞれ④, ③, ②, ①と表示してあります。

④40~70, ③60~120, ②100~200, ①160~320

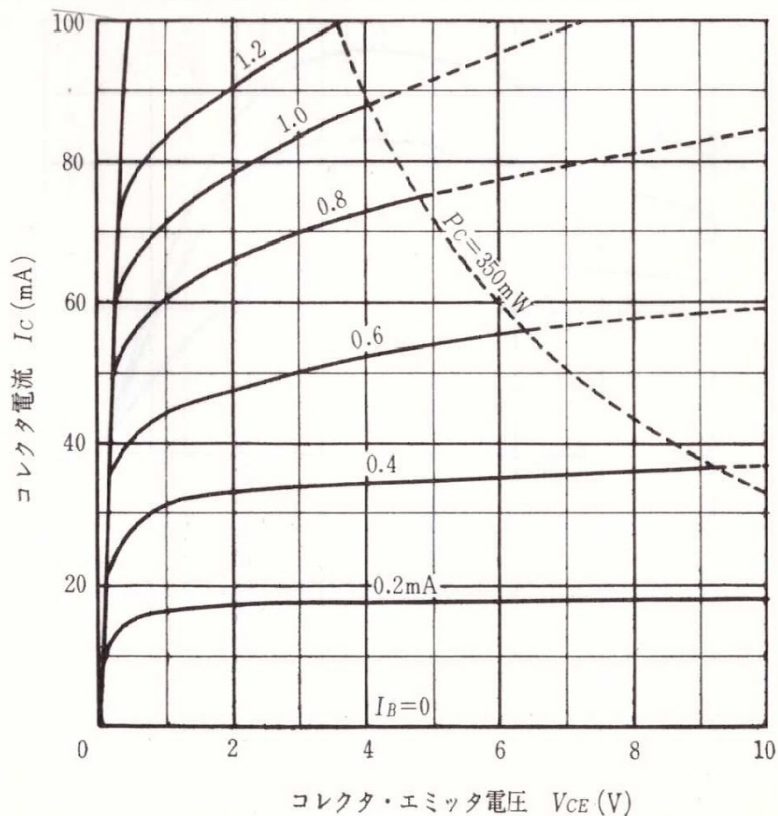
* The 2SC984 is grouped by h_{FE} as follows.

許容コレクタ損失の周囲温度による変化
MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE

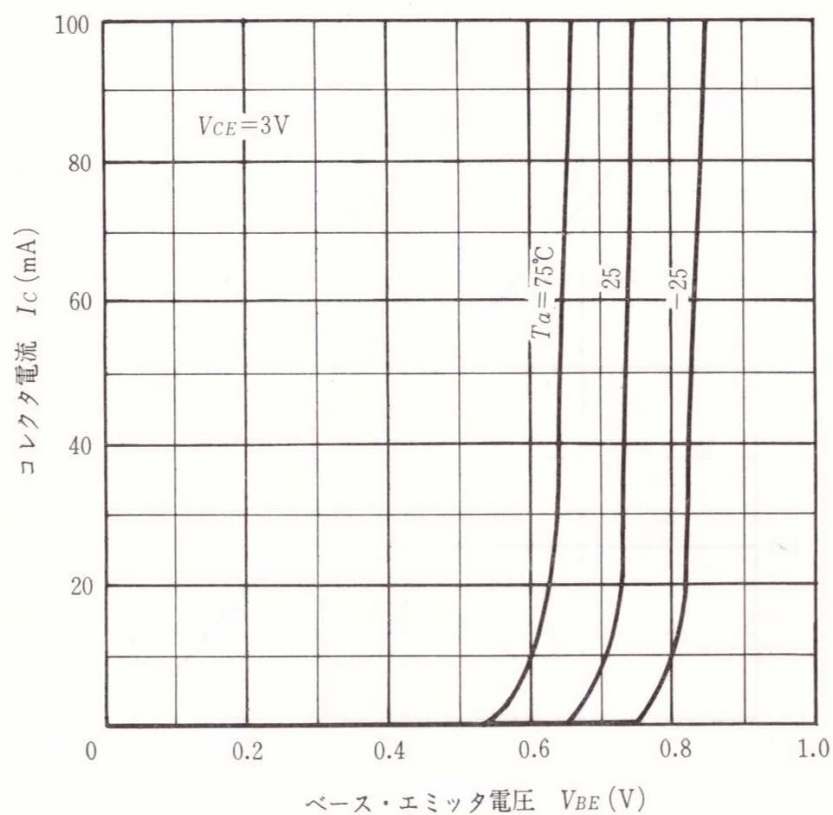


www.datasheetcatalog.com

エミッタ接地出力静特性
TYPICAL OUTPUT CHARACTERISTICS



エミッタ接地伝達静特性
TYPICAL TRANSFER CHARACTERISTICS



直流電流増幅率対コレクタ電流特性
DC CURRENT TRANSFER RATIO VS. COLLECTOR CURRENT

